

功率开关						
R_{SW}	SW导通电阻			0.8		Ω
I_{SWmax}	SW连续电流			0.5		A
I_{LEAK}	SW漏电流			0.5	5	μA
过温保护						
T_{SD}	过热保护温度			150		$^{\circ}C$
T_{SD-hys}	过热保护迟滞			20		$^{\circ}C$

注：两款方案对比，OCP2185 占有明显的优势，MOS 管的导通内阻为 0.25Ω ，BP1360 的导通内阻为 0.8Ω ，OCP2185 超低的导通内阻，可以输出高达 1A 的电流，而 BP1360 因导通内阻大，其 MOS 发热量大，从而管制其输出电流最大为 0.6A。

输出电流如下图对比：

OCP2185:

■ Absolute Maximum Ratings

Parameter	Symbol	Rating	Unit
Continuous pin voltage relative to GND	VIN	-0.3~36	V
SW voltage relative to GND	VSW	-0.3~36	V
CTRL pin input voltage	VCRTL	-0.3~6	V
DC or RMS Switch current	ISW-DC	1.25	A
Peak Switch current (<10%)	ISW-PK	2.5	A
Junction Temperature	TJ	150	$^{\circ}C$
Lead Temperature Soldering	TLEAD	300	$^{\circ}C$
Storage Temperature Range	TST	-65 to +150	$^{\circ}C$

BP1360:

极限参数(注 1)

符号	参数	参数范围	单位
V_{IN}	电源电压	-0.3~40	V
SW	功率开关的漏端	-0.3~40	V
CS	电流采样端 (相对 V_{IN})	+0.3~(-6.0)	V
DIM	开关使能、模拟和 PWM 调光端	-0.3~6	V
I_{SW}	功率开关输出电流	0.6	A
P_{DMAX}	功耗(注 2)	0.2	W
P_{TR}	热阻, SOT23-5 (θ_{JA})	300	$^{\circ}C/W$
T_J	工作结温范围	-40 to 150	$^{\circ}C$
T_{STG}	储存温度范围	-55 to 150	$^{\circ}C$
	ESD (注 3)	2	kV

如上图比较，OCP2185 的电流输出能力要明显优于 BP1360，在相同封装，相同电路和使用环境的情况下，OCP2185 的 IC 发热能力会比 BP1360 的要好，从电源的角度来看，低的发热量直接决定了电源本身的品质好坏，低的发热量也将提高电源本身和 LED 灯珠的使用寿命。

OCP2185 高精度低成本降压型 LED 恒流驱动 IC

可完全代替 BP1360

深圳市海立辉科技有限公司

联系电话：13828829830 杨生 座机：0755-82538095 QQ:2932115885